1000 Ω شريحة مقاومة غشائية رقيقة من GaAs



1000 Ω — LCRES-R1000OHM شريحة مقاومة غشائية رقيقة من GaAs.

المقاومة: 1000 Ω (نموذجي)؛ تيار التشغيل الخطي: 0.04 A (نموذجي)؛ أقصى تيار مسموح: 0.08 A (أقصى). أبعاد الشريحة في المستوى: 0.5 × 0.5 mm.

الخصائص الكهربائية TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
عدد المقاومات	-	-	-	-	1	-
عدد الأطراف	-	-	-	-	2	-
المقاومة	-	-	1000	-	-	Ω
تفاوت المقاومة	-	-	±5	-	-	%
تيار التشغيل الخطي	-	-	0.04	-	-	A

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى تيار مسموح	-	-	-	0.08	A

المواصفات البيئية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
درجة حرارة التخزين	-	-65	-	150	°C
درجة حرارة التشغيل	-	-55	-	125	°C

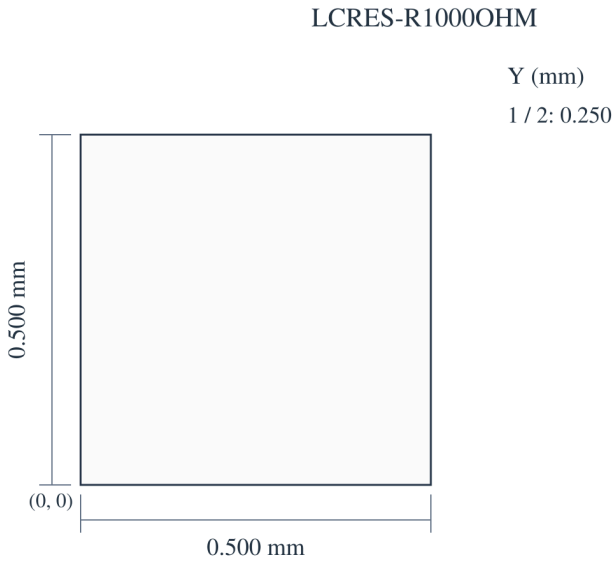
تعيين نقاط الربط

الأطراف	الرمز	الوظيفة	ملاحظات
1, 2	IN/OUT	دخل/خرج تبادلي	-
الوجه الخلفي للشريحة	GND	أرضي	RF / DC GND

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة في المستوى	0.5 × 0.5	mm

رسم مرجعي يعرض أبعادًا مختارة بوحدة mm. يتطلب التصنيع وربط الأسلاك رسومات كاملة.



سجل الإصدار الحالي · 1.3 · 2026-11-12. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.2.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز

يجب تأريض الوجه الخلفي للشريحة تأريضاً جيداً.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.